

SEMICONDUCTOR CLEANING AGENT

Patent number: JP2003100715
Publication date: 2003-04-04
Inventor: NANBA SATORU; ABE HISAOKI
Applicant: MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO
Classification:
- **International:** H01L21/3065; H01L21/304
- **European:**
Application number: JP20010287340 20010920
Priority number(s): JP20010287340 20010920

Abstract of JP2003100715

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor cleaning agent for removing a residual generating in etching, etc., in a process for manufacturing an element using a ferroelectric material. **SOLUTION:** This semiconductor cleaning agent is composed of a water solution containing polycarboxylic acid which is used for removing the residual which generates in the process for manufacturing the element using the ferroelectric material.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-100715

(P2003-100715A)

(43) 公開日 平成15年4月4日 (2003.4.4)

(51) Int.Cl.⁷

H 01 L 21/3065
21/304

識別記号

6 4 7

F I

H 01 L 21/304
21/302

テ-マコト^{*} (参考)

6 4 7 A 5 F 0 0 4
N

審査請求 未請求 請求項の数4 O.L (全3頁)

(21) 出願番号 特願2001-287340(P2001-287340)

(22) 出願日 平成13年9月20日 (2001.9.20)

(71) 出願人 000004466

三菱瓦斯化学株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

(72) 発明者 南場 哲

新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱
瓦斯化学株式会社新潟研究所内

(72) 発明者 阿部 久起

新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱
瓦斯化学株式会社新潟研究所内

(74) 代理人 100117891

弁理士 永井 隆

Fターム(参考) 5F004 AA09 BD01 DA26 DB08

(54) 【発明の名称】 半導体用洗浄剤

(57) 【要約】

【課題】 強誘電体材料を用いた素子の製造工程で、エッチング時などに発生する残渣物を除去するための半導体用洗浄剤を提供すること。

【解決手段】 強誘電体材料を用いた素子の製造工程で発生する残渣物を除去する際に使用する、ポリカルボン酸を含有する水溶液からなる半導体用洗浄剤。

【特許請求の範囲】

【請求項1】強誘電体材料を用いた素子の製造工程で発生する残渣物を除去する際に使用する、ポリカルボン酸を含有する水溶液からなる半導体用洗浄剤。

【請求項2】ポリカルボン酸が、シュウ酸である請求項1記載の半導体用洗浄剤。

【請求項3】更に、フッ素化合物を含有する請求項1記載の半導体用洗浄剤。

【請求項4】強誘電体材料が、タンタル酸ストロンチウムビスマスである請求項1記載の半導体用洗浄剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は強誘電体を使用した不揮発性メモリ製造工程で、エッティング時等に発生する残渣物の除去に使用する半導体用洗浄剤に関する。

【0002】

【従来の技術】コンピューター等に多用されているメモリは、従来は電源を切ると記憶されていたデータが消去されるため、常時通電するかバックアップ用の電源が必要とされていた。しかし近年、強誘電体材料を使用した不揮発性メモリが開発された。この不揮発性メモリはファイルメモリ、パーソナルI Cカード、移動体通信機器、携帯情報端末機器、AVパソコンなどへの使用が考えられている。不揮発性メモリの要である強誘電体材料としては、ジルコン酸チタン酸鉛(PZTと略称される)、タンタル酸ストロンチウムビスマス(SBTと略称される)などが使用される。また、強誘電体を使用した不揮発性メモリの電極材料としては、①電気抵抗が十分小さい、②強誘電体材料との格子定数のミスマッチが小さい、③耐熱性が高い、④反応性が低い、⑤拡散バリア性が高い、⑥二酸化珪素などの下地および強誘電体との密着性が良いなどの特性が要求され、白金(Plt)、酸化ルテニウム(RuO_x)、酸化イリジウム(IrO₂)などが使用される。

【0003】このため、不揮発性メモリ製造工程でエッティング時などに発生する残渣物は、これらの金属を含むものとなり、残渣物の除去が非常に難しいものとなっており、これらの残渣物を除去する技術が必要とされている。これらの残渣物を除去するためには、通常ヒドロキシルアミンを含有するアミン系剥離液などで除去する方法が一般的に実施されている。しかしながら、ヒドロキシルアミンを含有するアミン系剥離液は、安全性、環境の面で多くの問題点を有しており、さらに高温な条件下で使用しなければならない等の問題点も有している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は不揮発性メモリ製造工程でエッティング時などに発生する残渣物を除去する方法に使用する、安全で、かつ環境面でも優れた半導体用洗浄剤を提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前述の目的を解決するために鋭意検討を重ねた結果、ポリカルボン酸を含有する水溶液が、半導体用洗浄剤としてその目的に適合しうることを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。すなわち、本発明は、強誘電体材料を用いた素子の製造工程で発生する残渣物を除去する際に使用する、ポリカルボン酸を含有する水溶液からなる半導体用洗浄剤を提供するものである。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明の半導体用洗浄剤において用いられるポリカルボン酸は、単独で用いても、2種以上を組み合わせても良い。このようなポリカルボン酸として、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリソ酸、スペリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカンニ酸、ドデカンニ酸等の飽和ジカルボン酸類、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、グルタコン酸等の不飽和ジカルボン酸が挙げられる。上記ポリカルボン酸の中で、特に好ましくは、シュウ酸である。本発明に使用されるポリカルボン酸の含有量は、特に制限はなく、状況に応じて適宜選択されるが、通常は0.1～15重量%であり、好ましくは1～5重量%である。この量が0.1重量%未満では残渣物の除去速度が遅く、15重量%を超えると、ポリカルボン酸が析出する等の問題が発生するため好ましくない。

【0007】この洗浄剤による残渣物の除去方法としては、例えば洗浄剤中に、残渣物が生成した強誘電体材料を用いた基板を、浸漬する方法、洗浄剤中に上記基板を浸漬するとともに、超音波振動や攪拌羽根などにより、洗浄剤を攪拌する方法などを挙げることができる。また、洗浄剤の温度は残存している残渣物の状態から判断して適宜、選定すれば良く、通常、室温から沸点までの任意の温度で良いが、常温から90°Cが好ましく、特に20～70°Cが好ましい。さらに除去処理時間は特に制限はなく、除去方法や洗浄剤の温度などに応じて適宜選択すれば良い。

【0008】この洗浄液を使用して残渣物を除去した後に、使用するリノン液としては水で充分でありアルコールのような有機溶剤を使用する必要は無い。また、この洗浄剤に、残渣物の組成、性質に応じて適宜、界面活性剤、キレート剤、フッ素化合物等を添加しても良い。

【0009】さらに、本発明の洗浄剤の残渣物の除去能を向上させる目的で、所望により、フッ素化合物を含有させることができる。このフッ素化合物としては、フッ酸、フッ化アンモニウム、フッ化水素酸、フッ化水素アンモニウム、ホウフッ化アンモニウムなどが挙げられる。

【0010】このフッ素化合物は単独で用いても良く、2種以上を組み合わせて用いても良い。また、その含有量は特に制限は無く、状況に応じて適宜選択すれば良い。

が、通常は0.001～10重量%で、好ましくは0.1～1重量%である。0.001重量%未満では、残渣物の除去能の向上が十分に発揮されないおそれがあり、また10重量%を超えると、電極、Si基板等の腐食を引き起こすおそれがある。

【0011】

【実施例】次に、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。なお、図1は強誘電体材料を使用したメモリの製造工程の一部を示している。図2は実施例および比較例で用いた、金属配線を形成した後の、残渣物が存在する素子の模式的断面図である。図1に示したメモリの製造工程の一部は、Si基板6上に絶縁層5を設け、その上に下部電極4を形成する。さらに、その上に強誘電体材料3を形成し、ついで上部電極2を形成した後、絶縁層1で被ったものである。その後、ドライエッティング、O₂アッシングなどにより種々の金属配線8を形成してゆくが、その折に、図2に示したように、金属、有機物などを含む残渣物7が生成し、基板上に付着する。

【0012】実施例1

図2に示される素子を、シュウ酸3.4重量%を含有する水溶液中に40°C、5分浸漬し、その後超純水によりリーンを行い、乾燥後SEM観察を行ったが残渣物は完全に除去されていることが確認された。

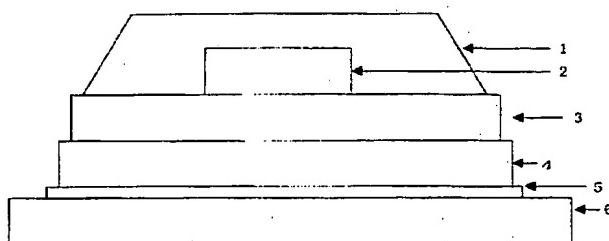
【0013】実施例2

図2に示される素子を、シュウ酸3.4重量%を含有する水溶液である洗浄液中に50°C、1分浸漬し、その後超純水でリーンを行い乾燥後SEM観察を行ったが残渣物は完全に除去されていることが確認された。

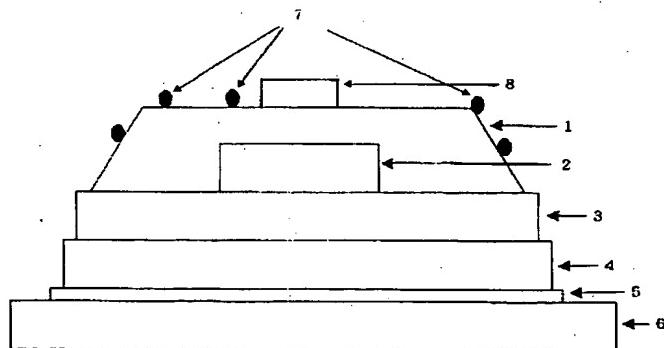
【0014】実施例3

図2に示される素子を、シュウ酸5.5重量%を含有する水溶液である洗浄液中に40°C、5分浸漬を行った。

【図1】



【図2】



その後超純水でリーンを行い乾燥後SEM観察を行ったが残渣物は完全に除去されていることが確認された。

【0015】実施例4

図2に示される素子を、シュウ酸3.4重量%とフッ化アンモニウム0.2重量%を含有する水溶液である洗浄液中に40°C、1分浸漬し、その後超純水でリーンを行い乾燥後SEM観察を行ったが残渣物は完全に除去されていることが確認された。

【0016】比較例1

図2に示される素子を、クエン酸3.4重量%を含有する洗浄液中に50°C、10分浸漬を行った。その後、超純水でリーンを行い乾燥後、SEM観察を行ったが、残渣物の減少はほとんど観察されなかった。

【0017】比較例2

図2に示される素子を、酒石酸3.4重量%を含有する洗浄液中に50°C、10分浸漬を行った。その後、超純水でリーンを行い乾燥後、SEM観察を行ったが、残渣物の減少はほとんど観察されなかった。

【0018】

【発明の効果】本発明の半導体用洗浄剤は、強誘電体材料を用いた素子の製造工程で発生する残渣物を、配線材等を腐食する事なしに、容易に除去することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】強誘電体材料を使用したメモリの製造工程の一部を示す、素子の模式的断面図である。

【図2】金属配線を形成した後の、残渣物が存在する状態の素子の模式的断面である。

【符号の説明】

1. 絶縁層、2. 上部電極、3. 強誘電体材料、4. 下部電極、5. 絶縁層、6. Si基板、7. 残渣物、8. 金属配線